

PNPエピタキシャル形シリコントランジスタ
低周波高利得増幅用

PNP Silicon Epitaxial Transistor
Audio Frequency High Gain Amplifier

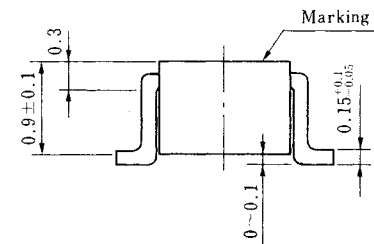
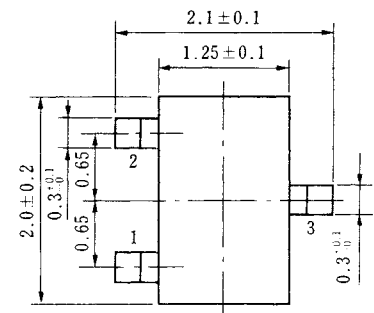
特徴

- 超小形外形であり、ハイブリッドIC用として最適です。
- 直流電流増幅率が大きい。
 $h_{FE} : 500 \text{ TYP. } (I_C = -1.0 \text{ mA})$
- 2SC4180とコンプリメンタリです。

絶対最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	略号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V_{CB0}	-120	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V_{CEO}	-120	V
エミッタ・ベース間電圧	V_{EBO}	-5.0	V
コレクタ電流	I_C	-50	mA
全損失	P_T	150	mW
ジャンクション温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

外形図(単位: mm)



電極接続
1. Emitter
2. Base
3. Collector
EIAJ: SC-70

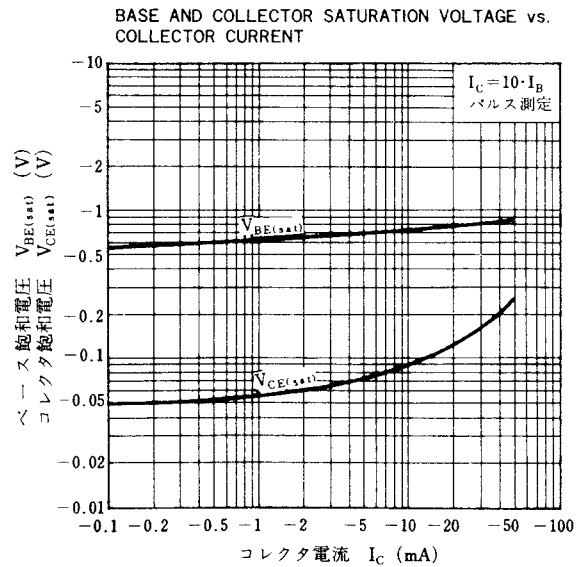
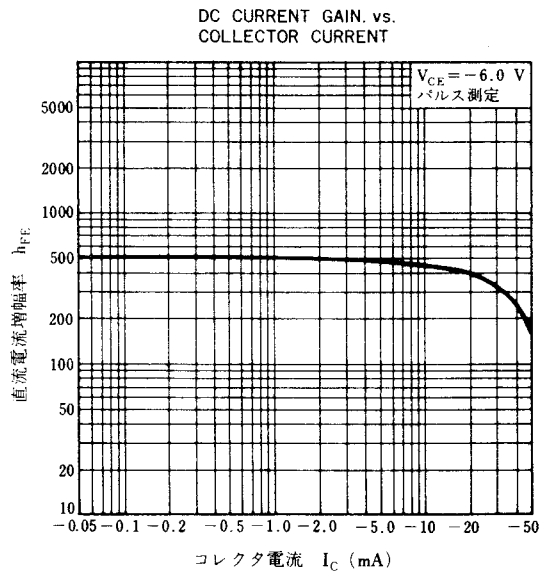
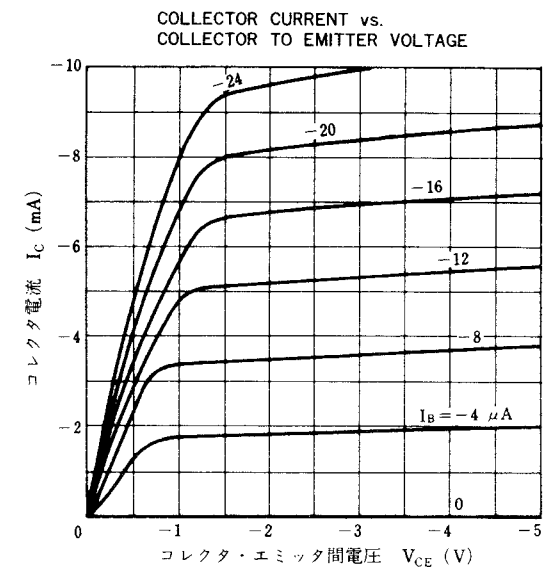
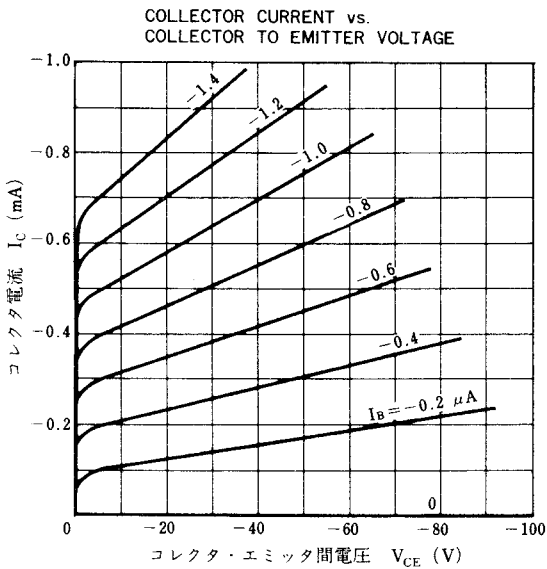
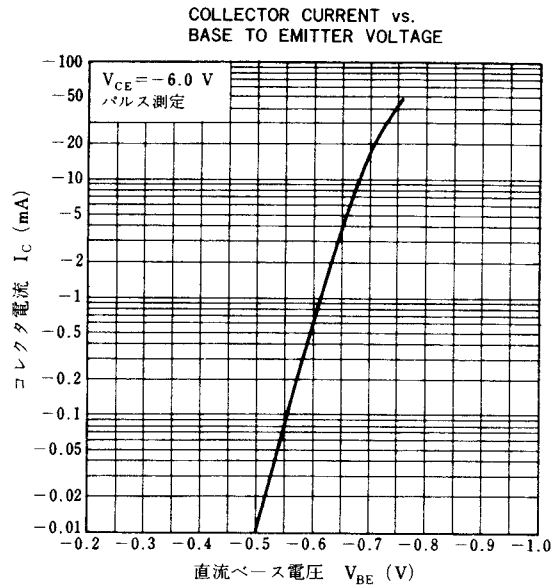
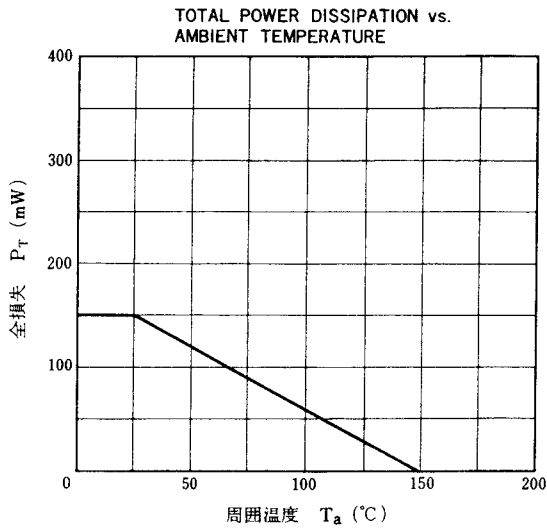
電気的特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタシャ断電流	I_{CB0}	$V_{CB} = -120 \text{ V}, I_E = 0$			-50	nA
エミッタシャ断電流	I_{EBO}	$V_{EB} = -5.0 \text{ V}, I_C = 0$			-50	nA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE} = -6.0 \text{ V}, I_C = -0.1 \text{ mA}$	100	500		
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE} = -6.0 \text{ V}, I_C = -1.0 \text{ mA}$	135	500	900	
直流ベース電圧	V_{BE}	$V_{CE} = -6.0 \text{ V}, I_C = -1.0 \text{ mA}$	-0.55	-0.61	-0.65	V
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = -10 \text{ mA}, I_B = -1.0 \text{ mA}$		-0.09	-0.3	V
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE} = -6.0 \text{ V}, I_E = 1.0 \text{ mA}$	50	90		MHz
コレクタ容量	C_{ob}	$V_{CB} = -30 \text{ V}, I_E = 0, f = 1.0 \text{ MHz}$		2.0	3.0	pF

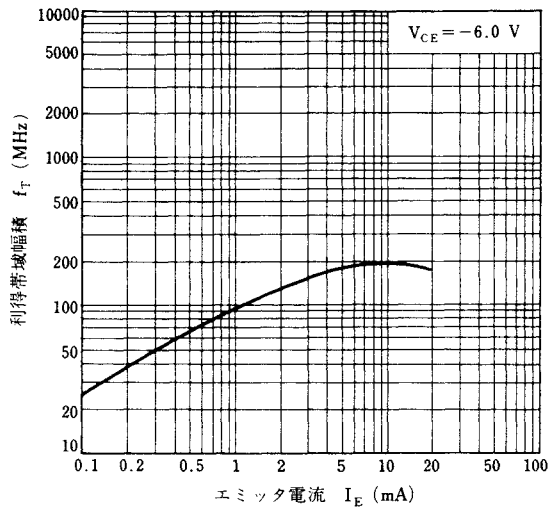
h_{FE} 規格区分

捺印	C15	C16	C17	C18
h_{FE2}	135~270	200~400	300~600	450~900

特性曲線 (T_a = 25°C)



GAIN BANDWIDTH PRODUCT vs.
EMITTER CURRENT



OUTPUT CAPACITANCE vs.
COLLECTOR TO BASE VOLTAGE

